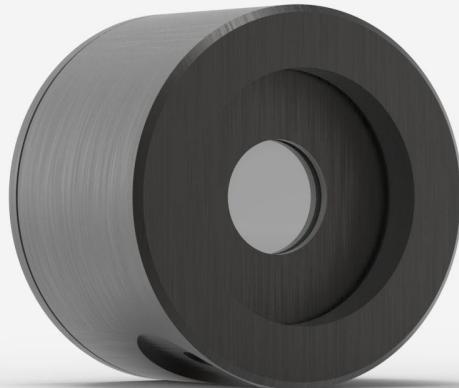


## PH100-SiUV-D0

Fotodioden-Detektor zur Laserleistungsmessung bis zu 4 mW.



### HAUPTMERKMALE DER PRODUKTFAMILIE

#### GROSSE APERTUREN

10 mm Ø für die Siliziumsensoren

#### 3 VERSIONEN

- Silizium 350 - 1080 nm, bis 750 mW
- Silizium-UV 210 - 1080 nm, bis 38 mW
- Germanium 800 - 1650 nm, bis 500 mW

#### WAHL DER ABSCHWÄCHER

#### HOHE MESSGENAUIGKEIT

Der neue PH100-Si-HA hat eine geringere Kalibrierunsicherheit

#### PRÄZISE KALIBRIERUNG

Auswahl der Wellenlänge in 1 nm-Schritten

#### INTELLIGENTE BENUTZEROBERFLÄCHE

Enthält alle Kalibrierungsdaten

#### KOMPATIBLER STÄNDER

[STAND-D-233](#)



## SPEZIFIKATIONEN

### MESSMÖGLICHKEITEN

Maximale Durchschnittsleistung <sup>1</sup>	4 mW
Äquivalente Rauschleistung <sup>2</sup>	10 pW
Spektralbereich	210 - 1080 nm
Typische Anstiegszeit	0.2 s
Unsicherheit der Leistungskalibrierung	±18 % (210 - 229 nm) ±8.0 % (230 - 254 nm) ±6.5 % (255 - 399 nm) ±2.5 % (400 - 899 nm) ±4.0 % (900 - 1009 nm) ±7.5 % (1010 - 1080 nm)
Spitzenempfindlichkeit	0.45 A/W @ 850 nm
Minimale Wiederholungsrate <sup>3</sup>	1000 Hz

1. Bei 532 nm. Siehe Kurven für die maximale Leistung bei anderen Wellenlängen.

2. Bei 850 nm. Nennwert. Der Istwert hängt von der elektromagnetischen Interferenz der Umgebung und der Wellenlänge ab.

3. Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch.

### ZERSTÖRSCHWELLE

Maximale durchschnittliche Leistungsdichte	100 W/cm <sup>2</sup>
--	-----------------------

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Apertur-Durchmesser	10 mm
Absorber	SiUV
Abmessungen	38.1Ø x 27.4D mm
Gewicht	0.13 kg
Abstand zur Sensorfläche	13,7 mm

### BESTELLINFORMATIONEN

PH100-SiUV-D0	200879
PH100-SiUV-IDR-D0	203231
PH100-SiUV-INT-D0	202788

Spezifikationen können sich ohne Mitteilung ändern. Siehe Benutzerhandbuch für vollständige Vorgaben.

## INTERESSIERT AN DIESEM PRODUKT?

EIN ANGEBOT ANFORDERN

Finden Sie Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter unter [gentec-eo.com/de/kontaktiere-uns](http://gentec-eo.com/de/kontaktiere-uns)